PF-ARの現状

PF-AR高度化共同チーム*

高エネルギー加速器研究機構 〒305-0801 茨城県つくば市大穂1-1

概要

PF-ARはX線領域の放射光実験のための単バンチ専用 の電子蓄積リングである。電子は3.0GeVで入射されて、 通常のユーザー運転では6.5GeV、医学利用では5.0GeV まで加速される。6.5GeVの通常運転での初期ビーム電流 は55mA、ビーム寿命は50mAのときで15時間となってい る。入射直後の単バンチ不純度は10[®]を達成しているが、 ユーザー運転中にその純度が悪化する現象が観測されてお り、これから解決しなければならない問題である。エミッ タンスについては現在の値290nm・radでは不十分であ り、達成可能な160 nm・radの実現を目指している。こ のリングにおける質の良いパルスX線はこれまで測定が困 難であった時間領域 and/or 時間分解測定を容易に測定 出来るものにしている。

1 はじめに

ARは本来、TRISTAN衝突リングのためのブースターシ ンクロトロンとして建設され、それと平行して1996年ま でX線源としても使用されていた。TRISTANプロジェク ト終了後、このリングはX線領域の放射光源専用電子蓄積 リング(PF-ARに改名)に改修された。しかし、このリ ングは単バンチ運転をメインにしているのにもかかわら ず、必要な単バンチ純度が常時確保されているわけではな かった。また、蓄積リングを主目的として建設されたので はないので、光源専用リングとしての性能はとうてい満足 出来るものではなかった。この状況を打破するために、 PF-ARの高度化共同チームが組織され、まずは最優先課 題である単バンチ純度化装置の構築にあたった。その間、 PF-ARの基本性能を高度化するための予算が採択され、 リングの改良、in-vacuumタイプの挿入光源と新しい ビームラインの設置が1999年に開始されている。この高 度化の作業は2001年末に終了し、2002年の1月初めにコ ミッショニングも成功裡に終わっており、リングを無事に 立ち上げることが出来た。その後、リングのパラメータの 微調整が施された後、4月からはユーザー運転を開始して いる。6.5GeV通常運転での初期ビーム電流は55mA、 ビーム寿命は50mAのときで15時間であり、単バンチ不純 度も10⁻8を達成している。質の良いパルスX線は、これま で測定が困難であった時間領域 and/or 時間分解測定 (核共鳴ブラッグ散乱実験、時間分解X線吸収 and/or 回 折測定等)を容易に測定出来るものにしている。また硬X 線の高い強度は蛋白結晶解析、医学利用、高エネルギーX 線回折及び散乱実験のためにも利用されている。

2 リングの性能

PF-ARは常時、単バンチモードで運転されている。電 子エネルギーは通常のユーザー運転時に6.5GeV、医学利 用時に5.0GeVとなる。リングの基本パラメータを表1に *連絡先 皆川 康幸 (yasuyuki.minagawa@kek.jp)



表1 PF-ARの基本パラメータ



示す。ビームエネルギーが高く、フルタイムに単バンチ運転されているのが、PF-ARの特徴である。

通常運転ではシングルバケットに55mAのビームが蓄積 され、44秒で最終エネルギー(5.0か6.5GeV)に加速され る。この加速の間に著しいビームロスは起こらない。高度 化プロジェクトの動機の一つは、ビーム寿命の著しい短さ (6.5GeV、40mAで約2時間)であった。これは、リング が蓄積リングを主目的として建設されなかったことに起因 しており、真空システムの改良によって大幅に改善され て、50mAでビーム寿命は15時間となっている[1]。この ビームの長寿命化によって、ビーム入射も以前の1日8回か ら1日3回にまで減少し、現在は1:00、10:00、17:00の定 時入射になっている。図1は1日のうちのビーム電流とビー ム寿命の変化を示したものである。

通常のユーザー運転中にビーム電流依存の軌道変動が観 測されている。これを抑えるために、グローバル軌道 フィードバックのシステムが構築された。このシステムに よって、水平及び垂直方向の軌道の変動はそれぞれ85µm から16µmへ、63µmから29µmへと改善されている。

5.0GeV運転時、いくつかの真空コンポーネントにおけ る温度が6.5GeV運転時に比べて著しく上昇しているのが 観測されている。この現象は5.0GeVにおけるバンチ長が 6.5GeVのときよりも短くなっているという事実に関係し ていると思われる。そこで、我々はシンクロトロン振動の 2倍の周波数でRFを変調して、バンチ長を引き延ばす試み を行った。これによって、バンチ長を10%引き延ばすこと に成功し、温度の上昇も軽減されることが確認されてい る。

PF-ARの現在のエミッタンスは90度オプティクスで 290nm・radである。このリングはブースターシンクロト ロンとして建設されているので、6.5GeVの光源としては リングの周長が短く、実現可能なエミッタンスは最小でも 160nm・radとなる。2003年4月、この値を実現すべく、 低エミッタンスオプティクスのスタディが開始された。 3.0GeV入射、低エミッタンスオプティクスの条件で電子 は入射出来たが、30mA以上の蓄積を実現することは出来 なかった。ビーム電流に制限が発生する原因は次の章で述 べられるものと同じビーム不安定性に引き起こされている と思われる。このビーム不安定性を避けることができるオ ペレーティングポイントの捜索、および6.5GeV (5.0GeV)への加速が次に我々がなすべきことである。

3 ビーム不安定性

PF-ARでは高度化後もいくつかのビーム不安定性が観 測されている。これらのビーム不安定性の発生源はいまだ 明らかではないが、対応策としてこのリングには以前から transverse方向のビームフィードバックのシステムが備え られている。高度化以前はビームフィードバックの稼働に よって2.5GeVの入射でビーム電流は最大40mAまで蓄積 されている。しかし、高度化後はビーム電流は15mAまで しか蓄積出来なかった。これはこの後述べられるように longitudinal方向のエミッタンスの縮小に伴うエネルギー スプレッドの減少によるものと考えられる。この状況を想 定して、我々は高度化時に八極電磁石を設置しておいた。 八極電磁石の稼働により、最大蓄積電流は47mAまで改善 されたが、これは満足出来る値ではなかった。そこで、 我々は入射エネルギーを3.0GeVに引き上げることを決断 した。この改善により、最大蓄積電流は67mAまで引き上 げられている。この最大蓄積電流に制限がかかってしまう ビームの入射問題について、ビームダイナミクスの観点だ けからではなく、マシンを安定に運転するためにも、その 原因を調べている[2、3]。一例として、ビーム入射時に現 れる横方向のビーム振動のパターンを図2に示す。これま でのところ、このパターンがビーム電流に依存し、ビーム フィードバック系の影響も受けていることが判明してい



図2 ビーム入射時に観測される横方向のビーム振動パ ターン。

る。この現象はビーム電流に制限が出来ることに関係して いるものと思われる。

PF-ARは単バンチ専用マシンなので、longitudinal方 向のカップリングインピーダンスは最も関心ある問題の-つである。我々は真空システムのカップリングインピーダ ンスが可能なかぎり小さくなるように設計し、ベローズは その内側にインピーダンスを小さくするためのシールドを 備えたものを採用している。高度化によるカップリングイ ンピーダンスの改善を評価するためにビーム電流によるバ ンチ長の変化を測定している。測定システムとしてはビー ムスペクトルからバンチ長を換算するシステム[4]を使用 しており、図3は高度化前後で測定されたバンチ長と計算 値を示している。図2に示されているように、測定結果と 計算値は低電流の範囲ではよく一致している。この結果か ら、longitudinalインピーダンスは高度化前後でそれぞれ 1.0±0.05、0.25±0.05Ωと評価出来る。シールド付きの ベローズのインピーダンスが無視出来るほど小さく、高度 化前後でマスクなどの他のコンポーネントに変化がないと 想定すると、この高度化前後でのインピーダンスの差は シールド無しのベローズのインピーダンスに等しいと推定 出来、その値は0.75Ωと評価することが出来る。このシー ルド無しベローズのインピーダンスの計算値は0.62Ωと算 出されているので、測定結果とよく一致している[5]。ま た、まだ測定は行われていないが、高度化によってエネル ギースプレッドが大幅に改善されていることが期待され る。



図3 高度化前後におけるバンチ長のビーム電流依存。自 然バンチ長で正規化している。

4 単バンチ不純度

単バンチ不純度(メインバケットに入った電子に対して 望まないバケットに入った電子の割合)が小さいことは放 射光実験の時間分解測定には本質的である。PF-ARで は、この望まないバケットに入った電子を選択的RFノッ クアウトシステムを用いて、ビーム入射時にふるい落とし ている。このシステムは6.5GeVに加速された後に停止さ せている。このシステムで初期時の単バンチ不純度は10^{*} が達成されている。

初期時にメインバケット以外のバケットに電子が存在し ない状態にあっても、単バンチ純度は徐々に悪くなってい く。これは、Touschek効果によってメインバケットから 飛び出した電子が次のバケットの開口部(radiation dampingによって発生する)に取り込まれる可能性があ るからである[6、7]。この問題は低エネルギーのリングで はよく問題にされるものであるが、PF-ARのような高エ ネルギーなリングでもいまだにその問題は存続している。 図4はユーザー運転中のメインバンチの不純度の成長の様 子を示している。図において点線で示されている不純度の 平均成長率は1.5×10⁻⁷/min、直線で示された不純度の成 長率の計算値は1.88×10⁻⁷/minとなっており、測定結果 とよくあっている。この計算はバケットの開口と、ZAP コードを使用してTouscheck寿命を計算したものであ り、xyカップリングは1%を仮定している。

この不純度の成長を防ぐために、水平方向のスクレー パーを使用してメインバケットからこぼれた電子を除去す る方法を試みる予定である[8]。また、選択的RFノックア ウトシステムのアンプの出力パワーを増強して、このシス テムが6.5GeVでも使用出来るようにする予定である。



図4 ユーザー運転中の不純度の成長

5 実験施設

PF-ARは二種類の測定、時間領域 and/or 時間分解測 定と硬X線の高い強度を利用した測定をカバーしている。 前者の主題は物質の中間状態と励起状態を明らかにするメ スバウアー分光時間領域測定と時間分解X線吸収 and/or 回折測定である。これらの実験はX線アンジュレータビー ムラインのNE3とNW2で行われている[9]。それら両方の 挿入光源はin-vacuumアンジュレータであり、NW2につ いてはtaperedアンジュレータにするためのメカニズムも 持っている[10]。このtaperedアンジュレータは時間分解 分散XAFS実験用の3次の相対的に広いエネルギースプ レッド(ΔE/E~10⁻¹)を得るためのものである。図5は低温 状態での⁸⁸Krの時間減衰スペクトルの一例を示している。 ⁸³Krのメスバウアー共鳴エネルギーは9.3keVである。⁸³Kr の半減期はほぼ140nsであるので、パルス間隔が長いパル スX線を利用する必要がある。1.26μsのパルス間隔のパ ルスX線を供給出来る単バンチ運転はこの種のメスバウ アー分光に役立っている。時間分解XAFS and/or 回折測 定については実験装置の立ち上げが図5 低温状況下での



⁸³Krの時間減衰スペクトルの例

進行中であり、最初のps時間分解測定は2004年初頭に行 われる予定である。後者の主題はNW12における蛋白結晶 解析[11]やNE1A2やNE5Aにおける医学利用[12]、NE1A1 における高分解コンプトン及び磁気コンプトン散乱測定、 NE5Cにおける高圧高温X線回折測定等である。とりわ け、蛋白結晶解析用に新しく建設されたX線アンジュレー タのビームライン (NW12) はMAD実験のために高い処 理能力をもった実験ステーションとしてよく整備されてい る。実験ステーションの総合的なパフォーマンスは回折 データセットを得るのにかかる時間からも3世代光源のパ フォーマンスとほとんど同等である。

参考文献

[1] Miyajima T. et al., Proc. 2003 Particle Accelerator Conf., 2003.

[2] Fujita T. et al., Proc. 2003 Particle Accelerator Conf., 2003.

[3] Minagawa Y. et al., Proc. 2003 Particle Accelerator Conf., 2003.

[4] Ieiri T., Nucl. Instrum. and Methods A329, 1993, pp. 371-380.

[5] Ieiri T. et al., Proc. 2003 Particle Accelerator Conf., 2003.

[6] Kasuga T. et al., Japan. J. Appl. Phys. 28, 1989, pp. 541.

[7] Obina T. et al., Nucl. Instrum. and Methods A354, 1995, pp. 204

[8] Tobiyama M. et al., Japan. J. Appl. Phys. 29, 1990, pp. 210

[9] Mori T. et al., Proc. 2003 Synchrotron Radiation Instrumentation conf.

[10] Yamamoto S. et al., Proc. 2003 Synchrotron Radiation Instrumentation conf.

[11] Matsugaki N. et al., Proc. 2003 Synchrotron Radiation Instrumentation conf.

[12] Hyodo K. et al., Proc. 2003 Synchrotron Radiation Instrumentation conf.